ОАО «ОКБ «Экситон»

142500 г. Павловский Посад Московской обл., ул. Интернациональная, д.34а

Тел. 8-(49643)-2-31-07, 8-(49643)-7-04-07

<u>www.okbexiton.ru</u> E-mail: <u>okbexiton@mail.ru</u>



1526ИР1

18-ти разрядный статический сдвигающий регистр.

Технология – КМОП

Технические условия исполнения бК0.347.458-10 ТУ.

Предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения.

Краткие основные характеристики:

Предельно допустимое напряжение питания от 4,5 В до 11 В.

Диапазон рабочих температур от -60°C до +85°C.

Время задержки распространения при включении (выключении), ≤ 800 нс при U_{CC}=5 B, C_L=50 пФ, T=25 °C.

Предельное напряжение питания U_{CC} от -0,2 В до 15,0 В.

Значение напряжения на входе от -0,5 В до (U_{CC} +0,5) В.

Стойкость к воздействию спецфакторов по ГОСТ В 20.39.404-81:

И1, И2, И3, К3 – 3У (при U_{CC} =5,0 B; 10,0 B); К1, С3 – 2У (при U_{CC} =5,0 B); К1, С3 – 3У (при U_{CC} =10,0 B); И8...И11,С1 – 3У; И4 – 0,075х9 В.

Табл. 1 - таблица назначения выводов микросхем 1526ИР1

Вывод	Обозначение	Назначение
1	D1	
1		Вход 1-го разряда
2	NC	Не подключен
3	С	Тактовый вход
4	D2	Вход 5-го разряда
5	D3	Вход 10-го разряда
6	D4	Вход 14-го разряда
7	0V	Общий
8	Q17	Выход 17-го
		разряда
9	Q18	Выход 18-го
		разряда
10	Q13	Выход 13-го
		разряда
11	Q8	Выход 8-го разряда
12	Q9	Выход 9-го разряда
13	Q4	Выход 4-го разряда
14	V _{CC}	Питание

Рис. 1. Условное графическое обозначение микросхем 1526ИР1

3	С	$ ext{RG} \! o$		
1	D1		Q4	13
4	D2		Q8 Q9	11 12
			Q9	12
5	D3		Q13	10
6	D4		Q17 Q18	8 9
5.0				,

Табл. 2 - таблица истинности для одной ячейки микросхем 1526ИР1

Вход		Выход		
С	D1-D4	Q17, Q13, Q8,Q4	Q18, Q9	
PIMP	Н	Χ	Χ	
PIMP	L	Χ	Χ	
PIMP	Н	Х	Χ	
PIMP	L	Н	Χ	
PIMP	Н	L	Н	
PIMP	L	Н	L	

Н – высокий уровень,

L – низкий уровень,

Х – любой уровень

РІМР – один полный положительный импульс

Табл. 3. Электрические параметры микросхем 1526ИР1, Б1526ИР1-1 ЭП при приемке и поставке

при приемке и пеставке				
Наименование параметра,	Буквенное	Норма па	араметра	Темпера-
единица измерения,	обозначение			тура
режим измерения	параметра	не менее	не более	среды, °С
1. Выходное напряжение низкого уровня, В,		-	0,01	-60
при:	UoL	-	0,01	25±10
Ucc=5,0 B; 10,0 B		-	0,05	85
2. Выходное напряжение высокого уровня, В,		4,99	-	-60
при:		4,99	-	25±10
Ucc=5,0 B		4,95	-	85
		9,99	-	-60
Ucc=10,0 B		9,99	-	25±10
		9,95	-	85
3. Максимальное выходное напряжение низкого		-	0,8	-60
уровня, В, при:	UoL max	-	0,8	25±10
Ucc=5,0 B		-	0,8	85
		-	1,0	-60
Ucc=10,0 B		-	1,0	25±10
		-	1,0	85
4. Минимальное выходное напряжение высокого		4,2	-	-60
уровня, В, при:	Uон min	4,2	-	25±10
Ucc=5,0 B		4,2	-	85
		9,0	-	-60
Ucc=10,0 B		9,0	-	25±10
		9,0	-	85
5. Выходной ток низкого уровня, мА, при:		0,155	-	-60
Ucc = 5,0 , U _{OL} =0,5 B	loL	0,125	-	25±10
		0,085	-	85
-		0,310	-	-60
Ucc = 10,0 B, U _{OL} =0,5 B		0,250	-	25±10
		0,175	-	85
6. Выходной ток высокого уровня, мА, при:		- 0,125	-	-60
Ucc = 5,0 B, U _{OL} =4,5 B	Іон	- 0,100	-	25±10
		- 0,070	-	85
	-	-0,250	-	-60
Ucc = 10,0 B, U _{OL} =9,5 B		- 0,200	-	25±10
		j - 0,140 j	-	85

Продолжение табл. 3

Наименование параметра, единица измерения,	Буквенное обозначение	Норма па	раметра	Темпера- тура
режим измерения	параметра	не менее	не более	среды, ⁰С
7. Входной ток низкого уровня, мкА,		-	- 0,05	-60
при: Ucc = 11,0 В	li∟	-	- 0,05	25±10
		-	- 1,00	85
8. Входной ток высокого уровня, мкА,		-	0,05	-60
при: Ucc = 11,0 В	liн	-	0,05	25±10
		-	1,00	85
9. Ток потребления (в статическом режиме), мкА,		-	5,0	-60
при: Ucc = 5,0 В	Icc	-	5,0	25±10
		-	150	85
11 40 0 B		-	10	-60
Ucc = 10,0 B		-	10	25±10
-		-	300	85
Ucc=11,0 B		-	25	-60
OCC-11,0 B		-	25	25±10
10.11		-	1000	85
10. Максимальная частота тактового сигнала, МГц,		0.5		
пр <u>и: Ucc = 5,0 B, C_L=50 пФ</u>	f _{CLCmax}	0,5	-	25±10
Ucc = 10,0 B, C _L =50 пФ		1,25	1	25±10
11. Время задержки распространения при		-	800	-60
включении (выключении), нс, при:	tpнL	-	800	25±10
Ucc=5,0 B, C _L =50 пФ	(tpLH)	-	950	85
		-	400	-60
Ucc=10,0 B, C _L =50 пФ		-	400	25±10
		-	550	85
12. Время перехода из состояния низкого		-	800	-60
(высокого) уровня в состояние высокого	t _{THL}	-	800	25±10
(низкого) уровня, нс, при:	(t _{TLH})	-	950	85
Ucc=5,0 B, C _L =50 пФ	, ,	-	400	-60
		-	400	25±10
Ucc=10,0 B, C _L =50 пФ		-	550	85

Обозначение микросхем при заказе (в договоре на поставку)

При заказе микросхем, предназначенных для автоматической сборки (монтажа) аппаратуры, после обозначения ТУ ставят букву «А»:

Обозначение микросхем при заказе в бескорпусном исполнении:

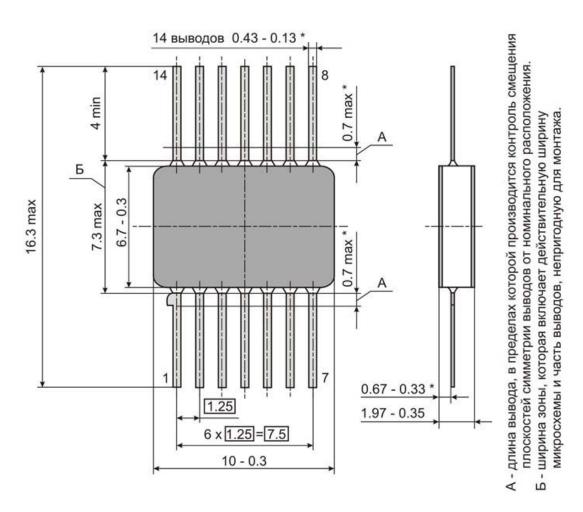
Чертеж кристалла УП7.344.156

Варианты конструктивного исполнения для поставок заказчику:

- в корпусе типа 401.14-5 с никелевым покрытием;
- в корпусе типа 401.14-5 с золотым покрытием;
- кристаллы без корпуса.

Возможно иное исполнение по требованиям Заказчика.

Корпус 401.14-5 размеры в миллиметрах



Для более полной информации о микросхеме использовать бК0.347.458ТУ, бК0.347.458-10 ТУ, УП3.487.209, УП3.487.209Э3